

**SF 816 · SF 817 · SF 818 · SF 819 pnp**  
**SF 826 · SF 827 · SF 828 · SF 829 npn**

Silizium-Hochfrequenztransistoren für Breitband-  
 verstärker und mittelschnelle Schalter

Bauform 11 TO92

Grenzwerte gültig für den Betriebstemperaturbereich

	SF 816, 817, 818, 819				SF 826, 827, 828, 829				
$U_{CBO}$	-20	-30	-60	-80	33	66	100	120	V
$U_{CEO}$	-20	-30	-60	-80	20	30	60	80	V
$I_C$		-500					500		mA
$I_{CM}$		-1 000					1 000		mA
$I_B$		250				-250			mA
$P_{tot} (\vartheta_a = 25^\circ C)$		735				735			mW
$\vartheta_j$		150				150			°C
$R_{thja}$		170				170			K/W
$\vartheta_a$	-40 ... +125				-40 ... +125				°C

Statische Kennwerte ( $\vartheta_a = 25^\circ C - 5 K$ )

$ I_{CBO} $	SF 816 ( $-U_{CB} = 20 V$ )	} $\leq 100 nA$	
	SF 817 ( $-U_{CB} = 30 V$ )		
	SF 818 ( $-U_{CB} = 60 V$ )		
	SF 819 ( $-U_{CB} = 80 V$ )		
	SF 826 ( $U_{CB} = 33 V$ )	} $\leq 100 nA$	
	SF 827 ( $U_{CB} = 66 V$ )		
	SF 828 ( $U_{CB} = 100 V$ )		
	SF 829 ( $U_{CB} = 100 V$ )	$\leq 60 nA$	
	( $U_{CB} = 120 V$ )	$\leq 1 000 nA$	
$ I_{EBO} $	SF 816 ... SF 819 ( $-U_{EB} = 5 V$ )	} $\leq 1 \mu A$	
	SF 826 ... SF 829 ( $-U_{EB} = 7 V$ )		
$ U_{(BR) CEO} $	( $ I_C  = 10 mA$ )	SF 816, SF 826 $\geq 20 V$ , SF 817, SF 827 $\geq 30 V$	
		SF 818, SF 828 $\geq 60 V$ , SF 819, SF 829 $\geq 80 V$	
$ U_{CEsat} $	( $ I_C  = 150 mA,  I_B  = 15 mA$ )	$\leq 0,5 V$	
$h_{21E}$	( $ U_{CE}  = 2 V,  I_C  = 50 mA$ )	Gruppe A	18 ... 35
		B	28 ... 71
		C	56 ... 140
		D	112 ... 280
		E	224 ... 560

Dynamische Kennwerte ( $\vartheta_a = 25^\circ C - 5 K$ )

$f_T (bel/U_{CE} / = 10 V, |I_C| = 10 mA, f = 15 MHz) \geq 60 MHz$